

УДК 535.343.2

© 1990

**ДИСПЕРСИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ  
И ЗАТУХАНИЕ СВЕТОЭКСИТОНОВ  
В ОБЛАСТИ 1B-РЕЗОНАНСА  
В КРИСТАЛЛЕ CdS**

*M. I. Страшникова, B. B. Черный*

Проведен детальный анализ перестройки светоэкситонных ветвей в области 1B-резонанса кристалла CdS при различных значениях параметра затухания. Сравнение рассчитанных кривых с экспериментально измеренной прямым методом призмы дисперсией показателя преломления позволило впервые определить особенности спектра затухания экситонов.

Сложная энергетическая структура 1B-экситона в кристалле CdS обусловлена линейными по волновому вектору  $\mathbf{K}$  членами, появление которых возможно в подзонах носителей симметрии  $\Gamma_7$ , [1]. На рис. 1, *a*, *e* представлена дисперсия экситонов (штриховые линии) и светоэкситонов

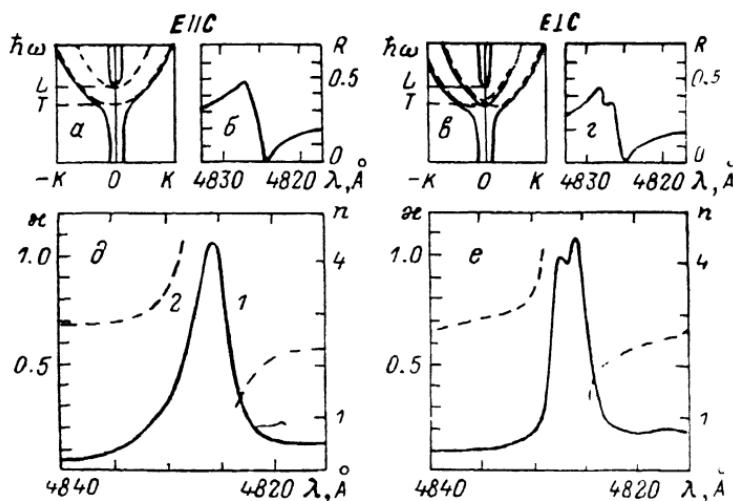


Рис. 1. Дисперсия светоэкситонов и экситонов (*a*, *e*), спектры отражения (*b*, *c*), спектры поглощения (*d*) и дисперсия показателей преломления (*2*) ( $\delta$ ,  $\epsilon$ ) в области 1B-резонанса при  $T=4.2$  К.

(сплошные) в области 1B-резонанса при  $\mathbf{K} \perp \mathbf{C}$  ( $\mathbf{C}$  — оптическая ось кристалла) и поляризациях света  $E \parallel C$  (*a*) и  $E \perp C$  (*e*) по работе [2]. Дно экситонной зоны при  $\mathbf{K} \perp \mathbf{C}$ ,  $E \perp C$  описывает в  $\mathbf{K}$ -пространстве так называемую петлю экстремумов, а число добавочных световых волн в соответствии с теорией Пекара [3] равно числу экситонов, попадающих в резонанс, т. е. двум. Это экситоны симметрии  $\Gamma_2$  и  $\Gamma_5$ . Всего в области 1B-экситона при  $\mathbf{K} \perp \mathbf{C}$ ,  $E \perp C$  имеются три светоэкситонные ветви. При  $\mathbf{K} \perp \mathbf{C}$ ,  $E \parallel C$  экситонная зона имеет обычный вид, поскольку линейные члены слабо смешивают состояния  $\Gamma_1$  и  $\Gamma_{5L}$ , не совпадающие по энергии при  $\mathbf{K}=0$  из-за продольно-поперечного расщепления  $\Delta_{1L}$ .

Такая сложная структура обуславливает целый ряд особенностей в оптических спектрах. Впервые они были обнаружены в спектрах отражения [4]. При  $E \perp C$  кривая  $R(\omega)$  имеет дополнительный максимум (рис. 1, *г*), который отсутствует при  $E \parallel C$  (рис. 1, *б*). На основании сравнения измеренных и рассчитанных кривых  $R(\omega)$  в [4] были определены параметры 1*B*-экспонионной зоны, в том числе и коэффициент  $\varepsilon$  при линейных по  $K$  членах. В дальнейшем спектры отражения при различных углах падения были подробно исследованы и проанализированы в [5].

Особенности, связанные с линейными по  $K$  членами, были обнаружены также в спектре поглощения тонкого «свободного» кристалла CdS толщиной 0.18 мкм [6]. Четкая дублетная структура полосы поглощения с более сильной коротковолновой компонентой наблюдалась в поляризации  $E \perp C$  (рис. 1, *е*), тогда как при  $E \parallel C$  полоса поглощения была одиночной и бесструктурной (рис. 1, *д*). Это полностью коррелирует со спектрами отражения.

В работах [7-9] обнаружены оптическая активность и эффект инверсии оптической оси кристалла CdS в области 1*B*-экспонионов, обусловленные линейными по  $K$  членами. Исследования по мандельштам-брюллюновскому рассеянию [2] позволили прямо восстановить ход светоэкспонионных ветвей. Начиная с резонансной частоты поперечного экспониона  $\omega_r$ , в поляризации  $E \perp C$  имеется дополнительная светоэкспонионная ветвь, что приводит к появлению в рассеянии дополнительных компонент-спутников.

Что же касается дисперсии показателя преломления, то долгое время ее удавалось измерить лишь на крыльях полосы поглощения [10-12]. На рис. 1, *д*, *е* представлены наши данные, полученные методом интерферометра Жамена, скрещенного со спектрографом, на монокристалле CdS толщиной 0.34 мкм. Сравнение кривых  $n(\omega)$  и  $p(\omega)$  показывает, что в области 1*B*-экспонионов, так же как в области 1*A*-экспонионов [13], не выполняются классические соотношения Крамерса-Кронига: размах кривой дисперсии на полуширине полосы поглощения примерно в три раза больше, чем максимальное значение  $\kappa$  (для классического осциллятора они должны быть равны)

$$\kappa = \lambda \ln(I_0/I)/4\pi d \equiv \text{Im } \bar{n}, \quad \bar{n} = n + i\kappa.$$

Впервые дисперсию показателя преломления в пределах всей полосы поглощения удалось измерить прямым методом призмы в [14]. Кратко сообщенные там экспериментальные данные подробно проанализированы в настоящей работе на основании сравнения их с рассчитанными кривыми  $n(\omega)$  при учете сложной структуры 1*B*-экспонионов и различных значениях константы затухания.

## 1. Дисперсия светоэкспонионов. Эксперимент и расчет

Измерения показателя преломления были выполнены на клинообразном монокристалле CdS средней толщиной 0.5 мкм с преломляющим углом  $\approx 50''$  при температуре 1.8 К. В качестве источника излучения использовался перестраиваемый лазер. Эксперимент подробно описан в [5, 15], а полученные результаты при  $E \perp C$  изображены на рис. 2, *б*, *в* точками. Как видно из рис. 2, на длине волны 4828.0 Å наблюдаются разрыв непрерывного хода кривой  $n(\omega)$  и резкий скачок вверх от значения  $n=5.5$  до 12.2. При дальнейшем увеличении энергии  $n(\omega)$  непрерывно возрастает, пока на  $\lambda=4826$  Å не появится еще одна дисперсионная ветвь. В очень узком спектральном интервале  $\Delta\lambda=0.5$  Å обе ветви существуют одновременно, а затем остается лишь нижняя кривая  $n(\omega)$ . Максимально измеренное значение  $n=17$ .

Если одновременное сосуществование двух волн выше продольной частоты  $\omega_L$  уже наблюдалось ранее в области 1*A*-экспонионов, то такого вида

разрыв кривой  $n(\omega)$  вблизи  $\omega_T$  зафиксирован в оптике впервые. Необходимо подчеркнуть, что такой разрыв можно обнаружить, лишь применяя метод призмы. Интерференционные методы измерения для этой

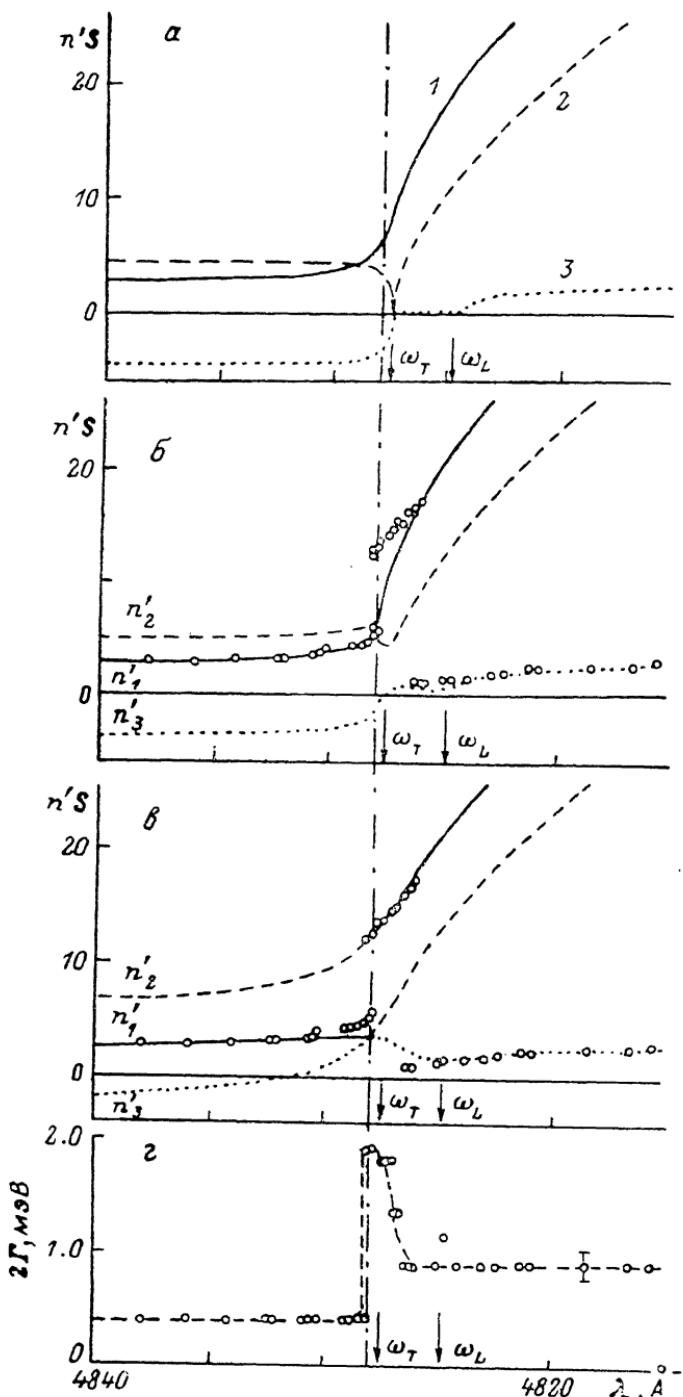


Рис. 2. Дисперсия показателей преломления при  $K \perp C$ ,  $E \perp C$  для  $2\Gamma=0$ ,  $S=K/|K|$  — единичный вектор в направлении распространения волны (α). Сравнение экспериментальной (точки) и рассчитанных кривых дисперсии для значений параметра затухания  $2\Gamma=0.4$  (β) и  $1.8$  мэВ (γ). Полученная зависимость  $2\Gamma(\omega)$  (ε).

Штрихпунктирная линия — положение дна экситонной зоны.

цели принципиально не годятся, поскольку скачок  $n(\omega)$  должен привести к сдвигу всей серии интерференционных полос, а положение нулевой полосы остается неизвестным.

При расчете светоэкситонных ветвей в области исследуемого резонанса использовалось такое же, как и в [4], уравнение, учитывающее пространственную дисперсию диэлектрической проницаемости при наличии линейных по  $\mathbf{K}$  членов, приведенное к виду

$$n^2 - \epsilon_0^* = \frac{b}{2} \left( \frac{1}{n^2 - \mu + an} + \frac{1}{n^2 - \mu - an} \right), \quad (1)$$

где

$$\epsilon_0^* = \epsilon_0 + \delta\epsilon = \epsilon_0 \left( 1 + \frac{4\pi\alpha_{1A}\omega_{1A}^2}{\omega_{1A}^2 - \omega^2} + \frac{4\pi\alpha_{2A}\omega_{2A}^2}{\omega_{2A}^2 - \omega^2} \right),$$

$$b = 4\pi\alpha_{1B}(M_1 c^2 / \hbar^2 \omega_{1B}^2 / h^2 \omega^2),$$

$$\mu = -\frac{M_1 c^2 \hbar \omega_{1B}}{h^2 \omega^2} \left[ 1 - \frac{\hbar \omega}{h \omega_{1B}} - i2\Gamma \frac{\hbar \omega}{h^2 \omega_{1B}^2} \right],$$

$$a = (2M_1 c^2 / h^2 \omega) \varphi, \quad \varphi = (m_h C_h - m_e C_e) / (m_e + m_h).$$

$4\pi\alpha$  — поляризуемость для соответствующего перехода;  $\omega$  — резонансные частоты;  $M_1 = (m_{e\perp} + m_{h\perp})$  — эффективная масса 1B-экситона для направления  $\mathbf{K} \perp \mathbf{C}$ ;  $C_e, C_h$  — коэффициенты при линейных по  $\mathbf{K}$  членах в зоне проводимости и валентной зоне;  $\epsilon_0$  — фоновое значение диэлектрической проницаемости, за исключением вкладов от 1A- и 2A-экситонов, учтенных в явном виде;  $2\Gamma$  — константа затухания (обозначена нами таким образом для удобства сравнения с соответствующей константой в теории Пекара [3]).

В соотношении (1) не учитывается расщепление между экситонными уровнями  $\Gamma_5, \Gamma_2$  и  $\Gamma_1$  за счет обменного взаимодействия электронов и дырок. В работе [17] на основании анализа экспериментальных данных, в том числе спектра поглощения работы [6], это расщепление было оценено довольно большим ( $\Delta_5 = 0.15, \Delta_2 = 0.55$  мэВ), поскольку в качестве положений термов  $\Gamma_5$  и  $\Gamma_2$  принимались положения максимумов дублетной полосы поглощения при  $\mathbf{E} \perp \mathbf{C}$ , а терма  $\Gamma_1$  — максимум одиночной полосы при  $\mathbf{E} \parallel \mathbf{C}$  (рис. 1, *d, e*). Однако в дальнейшем в работе [9] было показано, что эти расщепления значительно меньше ( $\Delta_5 = \Delta_2 = 0.01, \Delta_1 = 2\Delta_1 = 0.06$  мэВ). Причина расхождения состоит в том, что при существенности пространственной дисперсии диэлектрической проницаемости даже для простой экситонной зоны положение максимума полосы поглощения не совпадает с положением терма в отсутствие светоэкситонного смешивания, а сдвинуто в коротковолновую сторону. Из-за малости  $\Delta_1$  и  $\Delta_2$  они не учтены в соотношении (1).

Поскольку уравнение (1) является кубическим относительно  $n^2$ , оно имеет три решения — три светоэкситонные ветви. Уравнение решалось стандартным методом Кардано. На рис. 2, *a* представлены рассчитанные зависимости от частоты реальных частей  $n'$  показателей преломления  $n = n' + in''$  трех поперечных волн, распространяющихся в области 1B-резонанса без учета затухания, т. е. при  $2\Gamma = 0$ . Ниже частоты  $\omega_T$  реально в кристалле может распространяться лишь волна 1. Волны 2 и 3 являются комплексно-сопряженными и взаимно погашаются. Выше  $\omega_T$  возможно распространение двух волн, а выше продольной частоты  $\omega_T$  — трех. По мере роста параметра  $2\Gamma$  он проходит через два критических значения (названных так по аналогии с 1A-экситоном [18]). Когда достигается значение, равное  $2\Gamma_1^{kp}$ , ветви 1 и 2, начиная с частоты вблизи  $\omega_T$ , становятся генетически продолжением друг друга. В дальнейшем, после достижения  $2\Gamma_2^{kp}$ , начиная с этой же частоты, генетическим продолжением ветви 1 является уже ветвь 3, ветвь 2 — ветвь 1, а ветвь 3 — ветвь 2.

Сравнение теоретически рассчитанных кривых дисперсии с экспериментальной представлено на рис. 2, *b, c*. На рис. 2, *b* показаны рассчитанные кривые  $n'$  для значения параметра  $2\Gamma = 0.4$  мэВ, которое несколько больше, чем  $2\Gamma_1^{kp}$ , но меньше  $2\Gamma_2^{kp}$ . Ветви, являющиеся генетическим продолжением решений, полученных при  $2\Gamma = 0$ , обозначены соответ-

ственными сплошными ( $n'_1$ ), штриховыми ( $n'_2$ ) и пунктирными ( $n'_3$ ) линиями. Видно, что дисперсионная ветвь  $n'_1$  полностью описывает эксперимент (точки) вплоть до частоты разрыва в ходе кривой  $n(\omega)$ . Выше точки разрыва экспериментальные значения не укладываются на рассчитанную зависимость.

На рис. 2, в приведен аналогичный расчет при значении  $2\Gamma = 1.8$  мэВ, которое больше, чем  $2\Gamma_{\text{кр}}$ . Поэтому каждая ветвь является генетически составной. Как видно, теперь экспериментальные значения выше точки разрыва хорошо описываются теоретической зависимостью, а ниже — не согласуются с расчетом. Следует подчеркнуть, что рассчитанные при разных  $2\Gamma$  ветви  $n'_1(\omega)$  асимптотически сближаются по мере удаления от  $\omega_L$ , причем довольно быстро, поэтому высоконергетическая часть ветви оказывается малочувствительной к затуханию. В то же время ход кривой  $n'_1(\omega)$  в окрестности  $\omega_L$  очень зависит от величины  $2\Gamma$ .

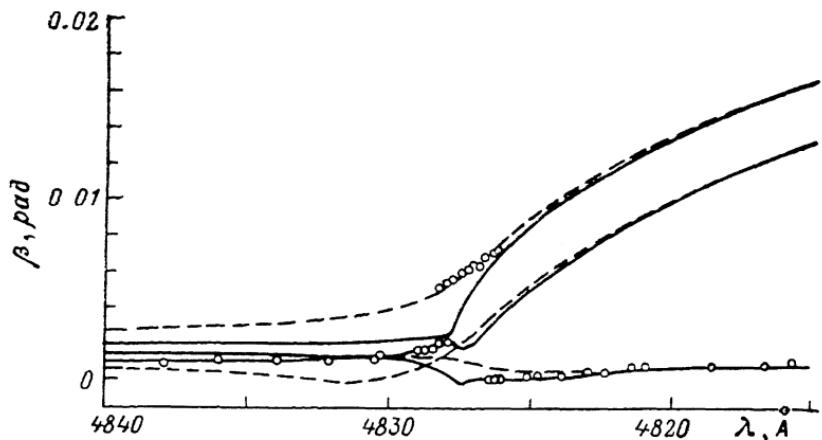


Рис. 3. Сравнение экспериментальных (точки) и рассчитанных углов отклонения светового пучка клинообразным кристаллом CdS в области 1B-экзитона.

Что же касается экспериментальных точек третьей светоэкзитонной ветви, которая измерена начиная примерно с середины области  $\Delta_{LT}$  и выше, то наилучшее согласие с расчетом получено при  $2\Gamma = 0.9$  мэВ. С этим же значением согласуется и ход ветви  $n'_1$  в этой спектральной области. Следует подчеркнуть, что третью ветвь можно зафиксировать в проходящем через кристалл свете в энергетическом интервале ниже продольной частоты только в том случае, когда значения  $n'_3$  становятся равными или больше единицы. Это происходит как раз начиная с  $2\Gamma = 0.9$  мэВ: при меньших  $\Gamma$  в области ниже  $\omega_L$   $n'_3 < 1$ .

Таким образом, чтобы согласовать экспериментально измеренную дисперсию показателя преломления с теоретическим расчетом, приходится предположить, что вблизи частоты разрыва резко возрастает  $2\Gamma(\omega)$  до 1.8 мэВ, а затем постепенно уменьшается до 0.9 мэВ. Полная зависимость  $2\Gamma(\omega)$  в резонансной области 1B-экзитона представлена на рис. 2, г. Каждая точка на графике соответствует такому значению  $2\Gamma$ , при котором совпадают экспериментальные и рассчитанные значения показателей преломления.

Напомним, что в работе [19] на основании анализа спектра пропускания того же монокристалла CdS в области 1A-резонанса было получено значение  $2\Gamma = 0.4$  мэВ начиная с  $\omega_L$  и выше. Таким образом, оказывается, что между 1A- и 1B-экзитонами  $2\Gamma$  сохраняет постоянное значение и не зависит от частоты.

Необходимо отметить, что при расчетах показателя преломления по измеренному углу отклонения  $\beta$  светового пучка клинообразным кристаллом с малым преломляющим углом  $\alpha$  использовалось приближенное соотношение

$$\operatorname{Re} \bar{n} = [\sin^2 \theta + \cos^2 \theta (1 + \beta/\alpha)^2]^{1/2}, \quad (2)$$

которое получается из точного выражения [20]

$$\beta = \alpha \{ \operatorname{Re} [(\bar{n}^2 - \sin^2 \theta)^{1/2}] / \cos \theta - 1 \}, \quad (3)$$

если пренебречь мнимой частью  $\bar{n}$ . При  $2\Gamma$ , использовавшихся в расчетах,  $\bar{n}_j = n'_j + i n''_j$  для каждой из волн — существенно комплексная величина. В этом случае пренебрежение мнимой частью показателя преломления не очевидно. Поэтому было проведено прямое сравнение углов отклонения каждой из волн, измеренных на эксперименте и теоретически рассчитанных по (3), если подставить туда соответствующие значения  $\bar{n}_j^2 = (n'_j + i n''_j)^2$ .

Основные параметры 1В-экзитона

$\omega_0$ , мэВ	$\Delta L T$ , мэВ	$2\Gamma$ , мэВ	$\varepsilon$ , мэВ · см	$M_{ex\perp}$	Ссылка
2.5676	1.4	0.4-1.8	$0.4 \cdot 10^{-9}$	1.1	Наст. раб.
2.568	1.25	—	$0.56 \cdot 10^{-9}$	1.2	[2]
2.5679	1.05	0.075	$0.5 \cdot 10^{-9}$	1.3	[4]
2.56815	1.4	0.26-0.6	$\varphi_1 = 0.6 \cdot 10^{-9}$ $\varphi_2 = 0.3 \cdot 10^{-9}$	1.3	[5]
2.56765	1.58	0.185	$\varphi_1 = 0.46 \cdot 10^{-9}$ $\varphi_2 = 0.58 \cdot 10^{-9}$	1.2	[6]

На рис. 3 изображены угловые отклонения трех поперечных волн для  $2\Gamma=0.4$  (сплошные линии) и 1.8 мэВ (штриховые). Как видно, согласие теоретических зависимостей и эксперимента (точки) принципиально ничем не отличается от приведенных на рис. 2, б, в графиков  $n'_j(\omega)$  при тех же параметрах затухания.

В таблице приведены определенные из расчетов параметры 1В-экзитона, а также для сравнения данные других работ.

## 2. Обсуждение результатов

Прежде чем перейти к обсуждению зависимости  $2\Gamma(\omega)$ , следует отметить, что точка разрыва в экспериментальной кривой  $n(\omega)$  совпадает с частотой дна экзитонной зоны (дна петли экстремумов), а не с резонансной частотой  $\omega_L$ . Именно на этой частоте и в расчетных зависимостях при возрастании  $2\Gamma$ , начиная с  $2\Gamma_1^{kp}$ , происходит разрыв непрерывности ветвей  $n'_1$  и  $n'_2$  и их генетическое продолжение друг в друга. Поэтому экспериментальные точки до и после разрыва принадлежат фактически одной дисперсионной ветви  $n'_1$ . Лишь в окрестности  $\omega_L$  актуальной становится третья светоэкзитонная ветвь ( $n'_3$ ). Характерно, что дополнительный длинноволновый максимум в спектре поглощения тонкого плоскопараллельного кристалла CdS (рис. 1, e) коррелирует со всплеском  $2\Gamma(\omega)$  на рис. 2, 2, а «просветление» кристалла выше основного коротковолнового максимума связано с появлением третьей светоэкзитонной волны.

По-видимому, резкое возрастание  $2\Gamma$  у дна петли экстремумов связано со смешиванием состояний экзитонов, попадающих в резонанс. Наибольшее смешивание и соответственно наибольшее возмущение должны иметь место в точке пересечения экзитонных ветвей — на резонансной частоте  $\omega_L$  и вблизи нее. Кроме того, начиная с частоты  $\omega_L$  и выше, вторая светоэкзитонная ветвь становится актуальной и в процессах межзонных перебросов. Об этом прямо свидетельствует появление в рассеянии Мандельштама—Бриллюэна дополнительных линий рассеяния на  $L_A$ - и  $T_A$ -фононах [2], что дополнительно увеличивает  $2\Gamma$ . После прохождения через резонанс зависимость  $2\Gamma(\omega)$  определяется только процессами внутри- и межзонного рассеяния и поэтому несколько уменьшается, выходя, по-видимому, на постоянное значение.

Однако неясным из сравнения эксперимента с расчетом остается вопрос, почему в области продольно-шарнирного расщепления  $\Delta_{1,1}$  видна сильно затухающая дисперсионная ветвь, а не кривая с аномальным участком, имеющая значительно меньшее  $n''$ . Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо в теории решить задачу пропускания клинообразного кристалла со сложной структурой зон, которая была решена в [20] для простой зоны 1A-экситона. В дальнейшем представляется интересным измерить наряду с дисперсией  $n(\omega)$  и интенсивности прошедших волн.

Таким образом, впервые установлена особенность релаксации 1B-экситонов, обусловленная их тонкой структурой и влиянием линейных по волновому вектору  $\mathbf{K}$  членов в зависимости  $E(\mathbf{K})$ . Она проявляется в резком возрастании константы затухания  $2\Gamma$  начиная с частоты, соответствующей центру экстремумов экситонной зоны. По-видимому, это связано со смешиванием взаимодействующих состояний и сильным возмущением светоэкситонного спектра, а также процессами межзонного рассеяния.

### Список литературы

- [1] Рацба Э. И., Шека В. И. // ФТТ. 1959. Т. 2. № 1. С. 162—176.
- [2] Koteles E. S., Winterling G. // Phys. Rev. Lett. 1980. V. 44. N 14. P. 943—951.
- [3] Пекар С. И. Кристаллооптика и добавочные световые волны. Киев, 1982. 295 с.
- [4] Mahan G. D., Hopfield J. J. // Phys. Rev. 1964. V. 135. N 2A. P. 428—433.
- [5] Broser I., Rosenzweig M. // Phys. St. Sol. (b). 1979. V. 95. N 1. P. 141—154.
- [6] Страшникова М. И., Рудчик А. Т. // ФТТ. 1972. Т. 14. № 4. С. 984—988.
- [7] Ивченко Е. Л., Пермогоров С. А., Селькин А. В. // Письма в ЖЭТФ. 1978. Т. 27. № 1. С. 27—29.
- [8] Ивченко Е. Л., Пермогоров С. А., Селькин А. В. // Письма в ЖЭТФ. 1978. Т. 28. № 10. С. 649—652.
- [9] Ивченко Е. Л., Селькин А. В. // ЖЭТФ. 1979. Т. 76. № 5. С. 1837—1855.
- [10] Бродин М. С., Страшникова М. И. // ФТТ. 1962. Т. 4. № 9. С. 2454—2460.
- [11] Бродин М. С., Крицкий А. В., Мясников Э. Н., Страшникова М. И., Шляхова Л. А. // УФЖ. 1973. Т. 18. № 5. С. 828—834.
- [12] Broser I., Broser R., Beckmann E., Birkicht E. // Sol. St. Comm. 1981. V. 39. № 11. P. 1209.
- [13] Страшникова М. И. // ФТТ. 1975. Т. 17. № 3. С. 729—734.
- [14] Лебедев М. В., Страшникова М. И., Тимофеев В. Б., Черный В. В. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 7. С. 1948—1954.
- [15] Лебедев М. В., Страшникова М. И., Тимофеев В. Б., Черный В. В. // Письма в ЖЭТФ. 1984. Т. 39. № 8. С. 366—369.
- [16] Демиденко А. А., Лебедев М. В., Пекар С. И., Страшникова М. И., Тимофеев В. Б., Цеквава Б. Е. // ЖЭТФ. 1985. Т. 89. № 7. С. 330—335.
- [17] Пикус Г. Е., Бир Г. Л. // ФТП. 1973. Т. 7. № 1. С. 119—131.
- [18] Davydov A. S., Myasnikov E. N. // Phys. St. Sol. (b). 1974. V. 63. N 1. P. 325—332.
- [19] Резниченко В. Я., Страшникова М. И., Черный В. В. // Письма в ЖЭТФ. 1989. Т. 49. № 10. С. 554—556.
- [20] Демиденко А. А., Пекар С. И., Цеквава Б. Е. // ФТТ. 1985. Т. 27. № 3. С. 741—747.

Институт физики АН УССР  
Киев

Поступило в Редакцию  
11 мая 1989 г.  
В окончательной редакции  
2 октября 1989 г.